

ЭФФЕКТ ХОЛЛА В САМОСОГЛАСОВАННОЙ ТЕОРИИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ

Е. А. Котов, М. В. Садовский

В рамках самосогласованной теории локализации рассмотрено поведение константы Холла и холловской подвижности вблизи порога подвижности (перехода Андерсона). Показано, что константа Холла не меняется по сравнению с обычным результатом для металлической области, холловская подвижность обращается на пороге подвижности в нуль (при $T=0$) пропорционально статической проводимости.

1. В последние годы активно развивается самосогласованный подход к теории локализации электронов в неупорядоченных системах. Предложенный впервые Гетце [1] и существенно развитый Фоллхардом и Вольфле [2] он стал в настоящее время удобным практическим методом расчета различных физических величин в системах, испытывающих переход Андерсона [3—6]. По-видимому, при этом достигается качественно правильное описание системы во всей области изменения параметров — от «хорошего» металла до андерсоновского диэлектрика, несмотря на отсутствие контролируемого малого параметра теории возмущений [4]. Последнее обстоятельство может оказаться существенным для количественного описания непосредственной окрестности порога подвижности (например, для нахождения соответствующих критических индексов [4]), однако оно, по-видимому, не очень важно для общей качественной картины явления локализации.

Эффект Холла относится к числу важнейших кинетических характеристик электронной подсистемы. Вместе с тем, насколько известно авторам, его рассмотрение в рамках самосогласованной теории локализации никем еще не проводилось (в формулировке Фоллхарда и Вольфле). В настоящее время существуют лишь расчеты первых локализационных поправок к эффекту Холла в слабонеупорядоченном металле [7, 8], а также рассмотрение эффекта Холла в рамках качественной скэйлинговой теории перехода Андерсона [9]. Поэтому микроскопический анализ эффекта Холла в рамках самосогласованной теории локализации представляет несомненный интерес и может существенно дополнить качественные соображения, используемые при обсуждении реальных экспериментов [10].

2. Наши расчеты будут основаны на общих соотношениях для проводимости в слабом магнитном поле, полученных в работе Фукуямы, Эбисавы и Вады [11]. Рассматривается система электронов в поле хаотически расположенных в пространстве рассеивающих центров, помещенная также в поле статического пространственно-неоднородного вектор-потенциала $A(r) = A_q e^{iqr}$. Тогда в линейном приближении по A_q тензор электропроводности системы, описывающий отклик на однородное внешнее электрическое поле с частотой ω , может быть представлен в виде [11] (e — заряд электрона, m — его масса, c — скорость света):

$$\sigma_{\mu\nu}(q\omega) = \sigma(q\omega) \delta_{\mu\nu} + \frac{1}{i\omega} K_{\mu\nu}^\alpha(q\omega) A_q^\alpha; \quad (1)$$

$$\sigma(q\omega) \delta_{\mu\nu} = \frac{1}{i\omega} \{ \Phi_{\mu\nu}(q\omega + i\varepsilon) - \Phi_{\mu\nu}(q0 + i\varepsilon) \}; \quad (2)$$

$$K_{\mu\nu}^\alpha(q\omega) = \frac{e^2}{mc} \delta_{\nu\alpha} \{ L_\mu(q\omega + i\varepsilon) - L_\mu(q0 + i\varepsilon) \} + \\ + \frac{1}{c} \{ L_{\mu\nu}^\alpha(q\omega + i\varepsilon) - L_{\mu\nu}^\alpha(q0 + i\varepsilon) \}, \quad (3)$$

причем $\Phi_{\mu\nu}(q\omega)$, $L_{\mu}(q\omega)$ и $L_{\mu\nu}^{\alpha}(q\omega)$ получаются обычным аналитическим продолжением $i\omega_m \rightarrow \omega + i\varepsilon$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$) из соответствующих мацубаровских корреляторов плотностей тока $J_{\mu}(q\tau)$ и заряда $\rho(q\tau)$ (τ — мацубаровское время, T_{τ} — операция T -упорядочения, $\omega_m = 2\pi mT$, T — температура):

$$\Phi_{\mu\nu}(q\omega_m) = T \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau' \exp\{i\omega_m(\tau - \tau')\} \langle T_{\tau} J_{\mu}(q\tau) J_{\nu}(0\tau') \rangle; \quad (4)$$

$$L_{\mu}(q\omega_m) = -T \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau' \exp\{i\omega_m(\tau - \tau')\} \langle T_{\tau} J_{\mu}(q\tau) \rho(-q\tau') \rangle; \quad (5)$$

$$L_{\mu\nu}^{\alpha}(q\omega_m) = T \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau' \int_0^{\frac{1}{T}} d\tau'' \exp\{i\omega_m(\tau - \tau')\} \langle T_{\tau} J_{\mu}(q\tau) J_{\nu}(0\tau') J_{\alpha}(-q\tau'') \rangle. \quad (6)$$

С использованием обычной «примесной» диаграммной техники [12] эти корреляторы могут быть приближенно представлены графиками, пока-

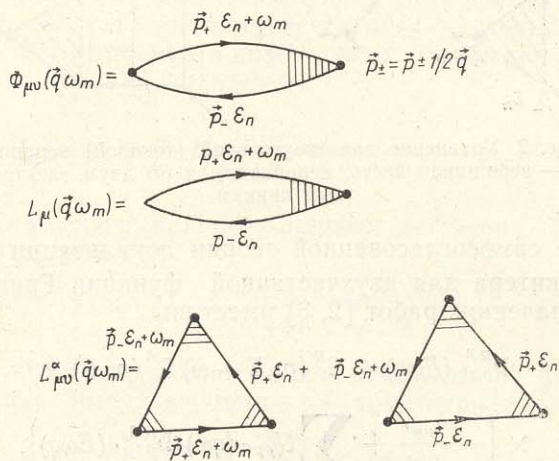


Рис. 1. Графики для мацубаровских корреляторов, определяющих тензор электропроводности в магнитном поле. Жирная точка обозначает токовый характер вершины, отсутствие точки — скалярная величина.

занными на рис. 1 [11], где «треугольная» (токовая) вершина описывается уравнением, графически представленным на рис. 2. Из рис. 1 видно, что мы пренебрегаем вкладом треугольных графиков, в которых топология линий рассеяния на беспорядке не сводится к перенормировке треугольных вершин. Мы полагаем, что учета треугольных вершин достаточно для качественного описания роли локализации, так как при этом учитываются процессы рассеяния, обычно рассматриваемые в самосогласованной теории [2, 3].

После довольно громоздкого анализа общих выражений (4) — (6), существенно использующего тождество Уорда, оказывается, что компоненты тензора электропроводности системы в магнитном поле для

случая вырожденной статистики электронов ($T \rightarrow 0$) представляются в виде [11]:

$$\sigma_{xx}(\omega) = \frac{e^2}{2\pi} \sum_p \frac{p_x^2}{m^2} \chi(p\omega) G^R(pE + \omega) G^A(pE); \quad (7)$$

$$\sigma_{xy}(\omega) = \frac{e^2}{4\pi i} \omega_c \sum_p \frac{p_x}{m} \chi^2(p\omega) \times \\ \times \left\{ G^R(pE + \omega) \frac{\partial}{\partial p_x} G^A(pE) - G^A(pE) \frac{\partial}{\partial p_x} G^R(pE + \omega) \right\}, \quad (8)$$

где $G^{R,A}(pE)$ — запаздывающая (опережающая) усредненная функция Грина электрона с энергией E (энергия Ферми) в поле случайных рассеивателей. Величина $\chi(p\omega)$ определяется как предел $q \rightarrow 0$ в выражении для токовой вершины

$$J_{\mu}(p\omega q) = \frac{e}{m} p_{\mu} \chi(p\omega q), \quad (9)$$

$\omega_c = eH/mc$ — циклотронная частота электрона в магнитном поле H , ориентированном вдоль оси z .

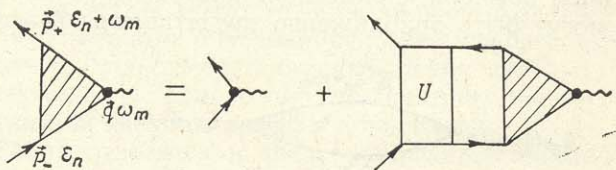


Рис. 2. Уравнение для треугольной (токовой) вершины. U — вершинная часть, неприводимая по двум электронным линиям.

3. В основе самосогласованной теории локализации лежит уравнение Бете—Солпитера для двухчастичной функции Грина $\Phi_{pp'}^{RA}(E\omega q)$, которое в обозначениях работ [2, 3] имеет вид

$$\Phi_{pp'}^{RA}(E\omega q) = G^R(p_+E + \omega) G^A(p_-E) \times \\ \times \left\{ -\frac{\delta_{pp'}}{2\pi i} + \sum_{p''} U_{pp''}^E(q\omega) \Phi_{p''p'}^{RA}(E\omega q) \right\}, \quad (10)$$

где $U_{pp''}^E(q\omega)$ — неприводимая по двум электронным линиям вершинная часть рассеяния на беспорядке. Соответственно интересующая нас токовая вершина определяется соотношением

$$-\frac{2\pi i e}{m} \sum_{p'} p'_\mu \Phi_{pp'}^{RA}(E\omega q) = G^R(p_+E + \omega) G^A(p_-E) J_{\mu}(p\omega q) \quad (11)$$

и удовлетворяет уравнению

$$J_{\mu}(p\omega q) = \frac{e}{m} p_{\mu} + \sum_{p'} U_{pp'}^E(q\omega) G^R(p'_+E + \omega) G^A(p'_-E) J_{\mu}(p'\omega q). \quad (12)$$

С использованием (11) и уравнений самосогласованной теории локализации [2, 3], аналогично тому, как это было проделано в работе [6] для скалярной вершины, находим (см. Приложение) следующее явное вы-

ражение для токовой вершины в d -мерном пространстве (v_F — скорость Ферми)

$$J_\mu(\rho\omega q) = \frac{e}{m} \rho_\mu \frac{\omega^2 + 2i\gamma\omega - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}{\omega^2 + \omega M_E(q\omega) - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}, \quad (13)$$

где $M_E(q\omega)$ — релаксационное ядро, которое (при $q \rightarrow 0$) определяется следующим уравнением самосогласования [2, 3]:

$$M_E(\omega) = 2i\gamma \left\{ 1 + \frac{1}{\pi N(E)} \sum_q \frac{1}{-i\omega + D_E(\omega) q^2} \right\}. \quad (14)$$

Здесь введен обобщенный коэффициент диффузии

$$D_E(q\omega) = i \frac{v_F^2}{d} \frac{1}{M_E(q\omega)}, \quad (15)$$

$\gamma = \pi r V^2 N(E)$ — борновская частота рассеяния электронов на точечных центрах, хаотически распределенных в пространстве с плотностью ρ ; V — амплитуда рассеяния на таком центре; $N(E)$ — плотность состояний электронов с энергией E . Уравнение (14) возникает ([2, 3] при использовании для $U_{pp'}^E(q\omega)$ последовательности графиков с максимально перекрещивающимися линиями рассеяния («куперон» [7]) с заменой классического коэффициента диффузии на обобщенный.

При $\omega \ll \gamma$, $q \ll \gamma/v_F$ (13) сводится к

$$J_\mu(\rho\omega q) \simeq \frac{e}{m} \rho_\mu \frac{D_E(\omega)}{D_0} \frac{-i\omega}{-i\omega + D_E(\omega) q^2}, \quad (16)$$

где $D_0 = v_F^2/2d\gamma$ — классический коэффициент диффузии. Тогда из (13), (16) немедленно получаем

$$\chi(\rho\omega) = \frac{\omega + 2i\gamma}{\omega + M_E(\omega)} \underset{\gamma \gg \omega}{\approx} \frac{D_E(\omega)}{D_0}. \quad (17)$$

4. Вычисляя компоненты тензора проводимости по формулам (7), (8), получаем (p_F — импульс Ферми, n — концентрация электронов)

$$\begin{aligned} \sigma_{xx}(\omega) &= \frac{e^2}{2\pi} \frac{p_F^2}{dm^2} \frac{\omega + 2i\gamma}{\omega + M_E(\omega)} \sum_p G^R(pE + \omega) G^A(pE) = \\ &= \frac{e^2}{2\pi} \frac{p_F^2}{dm^2} N(E) \frac{i}{\omega + M_E(\omega)} = \frac{ne^2}{m} \frac{i}{\omega + M_E(\omega)}, \end{aligned} \quad (18)$$

то есть обычный ответ [2, 3]. Здесь использован простейший вид функций Грина, используемый в самосогласованной теории

$$G^{R,A}(pE) = \left\{ E - \frac{p^2}{2m} \pm i\gamma \right\}^{-1}, \quad (19)$$

что, в частности, соответствует пренебрежению перенормировкой плотности состояний.

Решение уравнения самосогласования (14) в пределе $\omega \rightarrow 0$ дает [2—5]

$$M_E(\omega) = \frac{i}{\tau_E} - \frac{\omega_0^2(E)}{\omega}, \quad (20)$$

где $\omega_0^2(E) = -\lim_{\omega \rightarrow 0} \omega M_E(\omega) > 0$ в андерсоновском диэлектрике, то есть при $E < E_c$, где положение порога подвижности на шкале энергий определяется из условия $\omega_0^2(E_c) = 0$. При этом радиус локализации электронных состояний $R_{loc}^2(E) = v_F^2/\omega_0^2(E)$.

В металлической области (при $E > E_c$) $\omega_0^2(E) = 0$, а проводимость системы (при $\omega \rightarrow 0$, $T=0$) определяется перенормированным коэффициентом диффузии $D_E = (v_F^2/d) \tau_E$. Аналогичным образом получаем

$$\begin{aligned} \sigma_{xy}(\omega) &= \frac{e^2}{4\pi i} \omega_c \frac{(\omega + 2i\gamma)^2}{[\omega + M_E(\omega)]^2} \frac{p_F^2}{dm} \sum_p \{G^R(pE + \omega) [G^A(pE)]^2 - \\ &- [G^R(pE + \omega)]^2 G^A(pE)\} = -\frac{e^2 p_F^2}{dm^2} N(E) \omega_c \times \\ &\times \frac{1}{[\omega + M_E(\omega)]^2} = \frac{ne^2}{m} \omega_c \left\{ \frac{i}{\omega + M_E(\omega)} \right\}^2. \end{aligned} \quad (21)$$

Сравнивая (18) и (21), имеем

$$\sigma_{xy}(\omega) = \frac{H}{nec} [\sigma_{xx}(\omega)]^2. \quad (22)$$

В металлической области здесь можно перейти к статическому пределу ($\omega \rightarrow 0$) и используя обычное определение найти константу Холла

$$R_H = \frac{\sigma_{xy}}{H\sigma_{xx}^2} = \frac{1}{nec}, \quad (23)$$

которая оказывается равной своему классическому значению. Очевидно, что этот результат не зависит от конкретных приближений для неприводимой вершины $U_{pp}^E(q\omega)$, используемых при выводе уравнения самосогласования (14). В то же время учет возможной перенормировки плотности состояний (отсутствующей согласно (19) в самосогласованной теории) может привести к изменению результата (23) (ср. [10, 11]). Соответственно для холловской подвижности μ_H (угла Холла Θ_H) получаем

$$\mu_H \simeq \frac{c}{H} \Theta_H = \frac{c}{H} \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}} = R_H c \sigma_{xx}. \quad (24)$$

При $E \rightarrow E_c$ в металле (при $T=0$) $\sigma_{xx} \rightarrow 0$, так что холловская подвижность обращается в нуль на пороге подвижности, пропорционально статической проводимости.

Эти результаты совпадают с полученными в работе Шапиро и Абрахамса [9] в рамках обобщения элементарной скэйлинговой теории локализации [13], что не является неожиданным, поскольку самосогласованная теория локализации воспроизводит скэйлинговую картину перехода Андерсона [3]. Аналогично работе [9], мы пренебрегли влиянием внешнего магнитного поля H на обобщенный коэффициент диффузии $D_E(\omega)$. Роль магнитного поля в физике перехода Андерсона еще не вполне выяснена. Однако из простейших соображений ясно, что его влияние определяется величиной «циклотронной частоты» $\frac{e}{c} HD_E$, связанной с диффузионным характером движения электрона в неупорядоченной системе [7]. Очевидно, что при выполнении неравенства $\frac{e}{c} D_E H \ll T$, влиянием магнитного поля на диффузию (локализацию) можно пренебречь. При $T \rightarrow 0$ речь, таким образом, идет об эффекте

Холла в инфинитезимальном магнитном поле. Более последовательный учет магнитного поля в самосогласованной теории локализации требует рассмотрения в духе работы [14], где предложена схема самосогласования с двумя релаксационными ядрами. Наше рассмотрение справедливо для слабого внешнего поля H и достаточно высокой температуры T .

5. При $T=0$ и $\omega \rightarrow 0$ в области андерсоновского диэлектрика ($E < E_c$) $\mu_H = 0$ и мы не можем осмысленным образом определить константу Холла. Эта же трудность отмечена в работе [9]. В рамках самосогласованной теории можно, однако, предложить содержательные формулы для эффекта Холла и в андерсоновском диэлектрике, воспользовавшись искусственным приемом, предложенным в работе [15]. При конечных температурах проводимость в андерсоновском диэлектрике осуществляется посредством прыжкового механизма. Согласно [15], при не слишком низких температурах этот механизм проводимости можно описать формулами самосогласованной теории (полученными при $T=0$) путем простой замены ω на $\omega + i/\tau_{in}$, где τ_{in} — время свободного пробега относительно неупругих процессов рассеяния (электрон-фононные, электрон-электронные столкновения), которое, очевидно, определяется зависимостью типа

$$\frac{1}{\tau_{in}(T)} = A\Omega_0 \left(\frac{T}{\Omega_0}\right)^n, \quad (25)$$

где Ω_0 — характерная частота; $A \ll 1$ — константа взаимодействия; n — целое число, большее или равное единице для всех известных процессов неупругого рассеяния. Этот подход качественно справедлив, пока энергетическое расстояние между близкими в пространстве электронными уровнями (в пределах области с размерами порядка $R_{loc}(E)$) много меньше температуры, что выражается неравенством вида

$$T \gg \omega_0^2(E) \tau_E \sim \frac{1}{N(E) R_{loc}^d(E)}. \quad (26)$$

При более низких температурах проводимость определяется обычным прыжковым механизмом [10], что приводит к экспоненциальной (а не степенной) зависимости проводимости от температуры. Ограничиваясь областью температур, определяемой неравенством (26), можно выполнить переход $\omega \rightarrow 0$ и в диэлектрической области. Тогда нетрудно убедиться, что результат (23) остается в силе. Константа Холла не перенормируется в окрестности перехода Андерсона.

Для холловской подвижности с учетом того, что $\tau_{in} \gg \tau_E$, получаем

$$\mu_H \approx \begin{cases} \frac{e}{m} \tau_E \left[1 - \frac{\tau_E}{\tau_{in}(T)} \right] & (\text{металл, } E > E_c); \\ \frac{e}{m} \frac{\tau_E}{1 + (\omega_0^2(E) \tau_E) \tau_{in}(T)} & (\text{изолятор, } E < E_c). \end{cases} \quad (27)$$

В частности, в области локализации ($E < E_c$) имеем

$$\mu_H \approx \begin{cases} \frac{e}{m} \tau_E & \text{при } \omega_0^2(E) \tau_E \ll \tau_{in}^{-1} \text{ (высокие } T); \\ \frac{e}{m} \frac{1}{\omega_0^2(E) \tau_{in}(T)} & \text{при } \omega_0^2(E) \tau_E \gg \tau_{in}^{-1} \text{ (низкие } T). \end{cases} \quad (28)$$

При $T \rightarrow 0$ $\mu_H \rightarrow 0$, естественно, что «низкие» температуры в (28) подразумеваются не нарушающими общего условия (26). При высоких температурах из (27) и (28) видно, что переход Андерсона не проявляется и

в холловской подвижности. При «низких» температурах это, конечно, не так.

6. Пользуясь общим результатом (21), (22) и выражениями для $\sigma_{xx}(\omega)$, найденными в [3, 16], легко написать формулы для явной зависимости σ_{xy} от частоты ω

$$\sigma_{xy}(\omega) = \frac{ne^3}{m^2} \frac{H}{c} \frac{1}{4\gamma^2} \left(-\frac{i\omega}{2\gamma}\right)^{\frac{2(d-2)}{d}} \left[F_d\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)\right]^2, \quad (29)$$

где наиболее интересные асимптотики имеют вид

$$F_d\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right) \begin{cases} \left(-i\frac{\omega}{\omega^*}\right)^{2/d}, & \omega \ll \omega^*, \quad E < E_c \text{ (изолятор)}; \\ \left(-i\frac{\omega}{\omega^*}\right)^{\frac{2-d}{d}}, & \omega \ll \omega^*, \quad E > E_c \text{ (металл)}; \\ \text{const}, & \omega \gg \omega^*, \quad E \geq E_c. \end{cases} \quad (30)$$

Здесь характерная частота $\omega^* \sim \gamma \left| \frac{E - E_c}{E_c} \right|^{\frac{d}{d-2}}$. Полное выражение для функции $F_{d=3}\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)$ можно найти в работе [3]. Из (29), (30) видно, что на самом пороге подвижности ($E = E_c$) $\text{Re } \sigma_{xy}(\omega) \sim \text{Im } \sigma_{xy}(\omega) \sim \omega^{2/3}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приведем вывод явных выражений для «треугольных» вершин в самосогласованной теории. Определим

$$\Phi_p^n(E\omega q) = \sum_{p'} (\hat{p}' \hat{q})^n \Phi_{pp'}^{RA}(E\omega q), \quad (\text{П.1})$$

где \hat{p}' , \hat{q} — единичные вектора в направлении p' и q . Разлагая (П.1) по полиномам Лежандра $P_l(\cos \Theta qp)$ и ограничиваясь вкладом $l=0,1$, при малых ω и q имеем:

$$\Phi_p^n(E\omega q) = [-2\pi i N(E)]^{-1} \Delta G_p \{ \Phi^{n0}(E\omega q) + d (\hat{p} \cdot \hat{q}) \Phi^{n1}(E\omega q) \}; \quad (\text{П.2})$$

$$\Phi^{n0}(E\omega q) = \sum_p \Phi_p^n(E\omega q); \quad \Phi^{n1}(E\omega q) = \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q}) \Phi_p^n(E\omega q); \quad (\text{П.3})$$

$$\Delta G_p = G^R(p_+E + \omega) - G^A(p_-E). \quad (\text{П.4})$$

Используя определение (11) и соотношение

$$G^R(p_+E + \omega) G^A(p_-E) = -\frac{\Delta G_p}{\omega - \frac{1}{m} p \cdot q + 2i\gamma}, \quad (\text{П.5})$$

получаем

$$[J(p\omega q) \hat{q}] = \frac{e}{m} p \frac{1}{N(E)} \left[\omega - \frac{1}{m} p \cdot q + 2i\gamma \right] \{ \Phi^{10}(E\omega q) + d (\hat{p} \cdot \hat{q}) \Phi^{11}(E\omega q) \}. \quad (\text{П.6})$$

Аналогичным образом для скалярной вершины [6]

$$-2\pi i \sum_{p'} \Phi_{pp'}^{RA}(E\omega q) = G^R(p_+E + \omega) G^A(p_-E) \gamma(p\omega q) \quad (\text{П.7})$$

имеем

$$\gamma(p\omega q) = -\frac{1}{N(E)} \left[\omega - \frac{1}{m} p \cdot q + 2i\gamma \right] \{ \Phi^{00}(E\omega q) + d (\hat{p} \cdot \hat{q}) \Phi^{01}(E\omega q) \}. \quad (\text{П.8})$$

Из основного уравнения Бете—Солпитера (10) с использованием (П.2) получаем систему уравнений:

$$\omega \Phi^{n0}(E\omega q) - v_F q \Phi^{n1}(E\omega q) = \frac{1}{2\pi i} \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^n \Delta G_p; \quad (\text{П.9})$$

$$[\omega + M_E(q\omega)] \Phi^{n1}(E\omega q) - \frac{1}{d} v_F q \Phi^{n0}(E\omega q) = \frac{1}{2\pi i} \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^{n+1} \Delta G_p,$$

где [2]:

$$M_E(q\omega) = 2i\gamma + \frac{id}{2\pi N(E)} \sum_{pp'} (\hat{p} \cdot \hat{q}) \Delta G_p U_{pp'}^E(q\omega) \Delta G_{p'} (\hat{p}' \cdot \hat{q}). \quad (\text{П.10})$$

Решение системы (П.9) имеет вид:

$$\Phi^{n1}(E\omega q) = \frac{1}{2\pi i \text{Det}} \left\{ \frac{1}{d} v_F q \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^n \Delta G_p + \omega \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^{n+1} \Delta G_p \right\};$$

$$\Phi^{n0}(E\omega q) = \frac{1}{2\pi i \text{Det}} \left\{ v_F q \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^{n+1} \Delta G_p + [\omega + M_E(q\omega)] \sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^n \Delta G_p \right\}; \quad (\text{П.11})$$

$$\text{Det} = \omega^2 + \omega M_E(q\omega) - \frac{1}{d} v_F^2 q^2. \quad (\text{П.12})$$

При $q \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow 0$ имеем: $\sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^n \Delta G_p = 0$ (нечетные n).

$$\sum_p (\hat{p} \cdot \hat{q})^2 \Delta G_p = [-2\pi i N(E)] d^{-1}. \quad (\text{П.13})$$

Соответственно:

$$\Phi^{00}(E\omega q) = -N(E) \frac{\omega + M_E(q\omega)}{\text{Det}};$$

$$\Phi^{01}(E\omega q) = \Phi^{10}(E\omega q) = -N(E) \frac{v_F q}{d \text{Det}}; \quad (\text{П.14})$$

$$\Phi^{11}(E\omega q) = -N(E) \frac{\omega}{d \text{Det}}.$$

Используя (П.14) в (П.8), получаем

$$\gamma(p\omega q) = \left[\omega - \frac{1}{m} p \cdot q + 2i\gamma \right] \frac{\omega + M_E(q\omega) + \frac{1}{m} p \cdot q}{\omega^2 + \omega M_E(q\omega) - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}, \quad (\text{П.15})$$

то есть выражение, использовавшееся в работе [6].

Аналогично, для векторной вершины из (П.6) имеем

$$[J(p\omega q) \cdot \hat{q}] = \frac{e}{m} p \left[\omega - \frac{1}{m} p \cdot q + 2i\gamma \right] \frac{\frac{1}{d} v_F q + \omega (\hat{p} \cdot \hat{q})}{\omega^2 + \omega M_E(q\omega) - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}. \quad (\text{П.16})$$

Умножая (П.16) на \hat{q}_μ и усредняя по направлениям \hat{q} с использованием свойств изотропии системы

$$\langle\langle \hat{q}_\mu \hat{q}_\nu \rangle\rangle = \delta_{\mu\nu}; \quad \langle\langle \hat{q}_\mu \rangle\rangle = \langle\langle \hat{q}_\mu \hat{q}_\nu \hat{q}_\delta \rangle\rangle = 0, \quad (\text{П.17})$$

немедленно получим (13)

$$J_\mu(p\omega q) = \frac{e}{m} \rho_\mu \frac{\omega^2 + 2i\gamma\omega - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}{\omega^2 + \omega M_E(q\omega) - \frac{1}{d} v_F^2 q^2}. \quad (\text{П.18})$$

Институт физики металлов
УНЦ АН СССР
Амурский комплексный НИИ
ДВНЦ АН СССР
Благовещенск

Поступила в редакцию
10 ноября 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Götze W. A. Theory of the Conductivity of a Fermion Gas Moving in a Strong Three-Dimensional Random Potential. — J. Phys. C., 1979, 12, p. 1279—1296.
2. Vollhardt D., Wölfle P. Diagrammatic, Self-Consistent Treatment of the Anderson Localization Problem in $d \leq 2$ Dimensions. — Phys. Rev. B., 1980, 22, № 10, p. 4666—4679.
3. Wölfle P., Vollhardt D. Self-Consistent Diagrammatic Theory of Anderson Localization. — In.: Anderson Localization, ed. by Y. Nagaoka, H. Fukuyama. Springer Series in Solid State Sciences, 39, p. 26—43. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, N. Y., 1982.
4. Мясников А. В., Садовский М. В. Самосогласованная теория локализация в пространствах с размерностью $2 \leq d < 4$. — ФТТ, 1982, 24, № 12, с. 3569—3574.
5. Котов Е. А., Садовский М. В. Self-Consistent Theory of Localization for the Anderson Model. — Zs. Phys. B, 1983, 51, № 1, p. 17—23.
6. Кацнельсон М. И., Садовский М. В. Межэлектронное взаимодействие в самосогласованной теории локализации. — ФТТ, 1983, 25, № 11, с. 3372—3382.
7. Altschuler B. L., Khmel'nitskii D. E., Larkin A. I., Lee P. A. Magnetoresistance and Hall Effect in a Disordered Two-Dimensional Electron Gas. — Phys. Rev. B, 1980, 22, № 11, p. 5142—5153.
8. Fukuyama H. Hall Effect in Two-Dimensional Disordered Systems. — J. Phys. Soc. Japan, 1980, 49, № 2, p. 644—651.
9. Shapiro B., Abrahams E. Scaling Theory of the Hall Effect in Disordered Electronic System. — Phys. Rev. B, 1981, 24, № 7, p. 4025—4030.
10. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1982, т. 1, 2, 664 с.
11. Fukuyama H., Ebisawa H., Wada Y. Theory of Hall Effect I. — Progr. Theor. Phys., 1969, 42, № 3, p. 494—511.
12. Абрикосов А. А., Горьков Л. П., Дзялошинский И. Е. Методы квантовой теории в статистической физике. М.: Физматгиз, 1962, 444 с.
13. Abrahams E., Anderson P. W., Licciardello D. C., Ramakrishnan T. V. Scaling Theory of Localization: Absence of Quantum Diffusion in Two-Dimensions. — Phys. Rev. Letters, 1979, 42, № 10, p. 673—676.
14. Yoshioka D., Оно Y., Fukuyama H. Self-Consistent Treatment of Two-Dimensional Anderson Localization in Magnetic Fields. — J. Phys. Soc. Japan, 1981, 50, № 10, p. 3419—3426.
15. Gogolin A. A., Zimanyi G. T. Hopping Conductivity and Weak Localization in Two-Dimensional Disordered Systems. — Solid. State Comm., 1983, 46, № 6, p. 469—475.
16. Shapiro B. Self-Consistent Calculation of the Frequency-Dependent Conductivity Near the Anderson Transition. — Phys. Rev. B, 1982, 25, № 6, p. 4266—4269.